

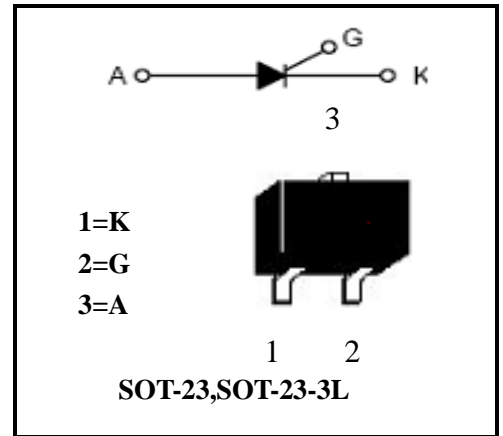
## MCR100-6(SOT-23)单向可控硅

### n 特点:

先进的玻璃钝化芯片、具有灵敏的控制极触发电流，通态压降低。

### n 用途:

广泛应用于各种万能开关器、小型马达控制器、彩灯控制器、漏电保护器、灯具继电器激励器、逻辑 集成电路驱动、大功率可控硅门极驱动、摩托车点火器等线路功率控制。



### n 极限参数:

名称	符号	规范值	单位	测试条件
重复峰值阻断电压	$V_{DRM}$	>600	V	$I_{DRM}=20\mu A$
反向重复峰值电压	$V_{DRM}$	>600	V	$I_{RRM}=50\mu A$
通态电流	$I_{T(RMS)}$	0.8	A	正弦波, 180 度
浪涌电流	$I_{TSM}$	10	A	正弦波, 50HZ
结温	$T_j$	125	$^{\circ}C$	----
储存温度	$T_{stg}$	-40~150	$^{\circ}C$	----

### n 电特性 ( $T_c=25^{\circ}C$ ):

名称	符号	测试条件	Min	Max	单位
重复峰值阻断泄漏电流	$I_{DRM}$	$V_D=V_{DRM}$	----	100	$\mu A$
通态电压	$V_{TM}$	$I_T=0.6A$	----	1.7	V
门极触发电流	$I_{GT}$	$V_D=7V, I_T=0.1A$	----	120	$\mu A$
门极触发电压	$V_{GT}$	$V_D=7V, I_T=0.1A$	----	0.9	V
门极不触发电压	$V_{GD}$	$V_D=V_{DRM}$	0.2	----	V
断态电压临界上升率	$dv_D/dt$	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=110^{\circ}C$	10	----	V/ $\mu s$